

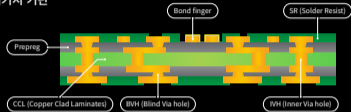
BGA (UTCSP)

개요

OVERVIEW

Wire Bonding으로 반도체 칩을 연결하는 패키지 기판

- 130 μm 이하 박판 구조 (3L : 모바일 DRAM, 4L : eMCP)
- 응용분야 : 모바일 메모리 칩

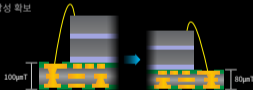


차별화

DIFFERENTIATION

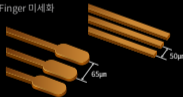
박형 Coreless 기판 개발

- 두께 축소 및 강성 확보



미세회로 개발 (mSAP공법)

- Bond Finger 미세화



주요 사양

KEY SPECIFICATIONS

기판 두께 (3L/4L)	80 μm /120 μm
Bond Finger Pitch	6.5 μm
회로 (Line/Space)	25/25 μm